

2SJ271

PチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・超高速スイッチング。
 - ・低電圧駆動。

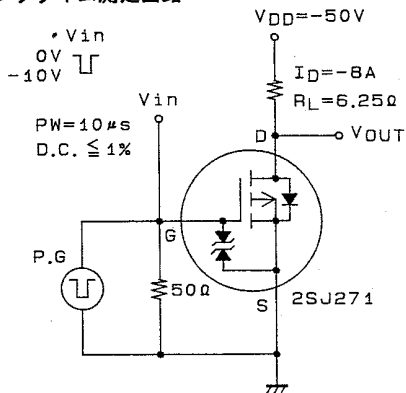
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25°C

			unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DSS}	-100	V
ゲート・ソース電圧	V _{GSS}	±15	V
ドレイン電流 (DC)	I _D	-15	A
ドレイン電流 (パルス)	I _{DP}	PW ≤ 10μs, duty cycle ≤ 1%	A
許容損失	P _D	Tc=25°C	W
チャンネル温度	T _{ch}	150	°C
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	°C

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25°C

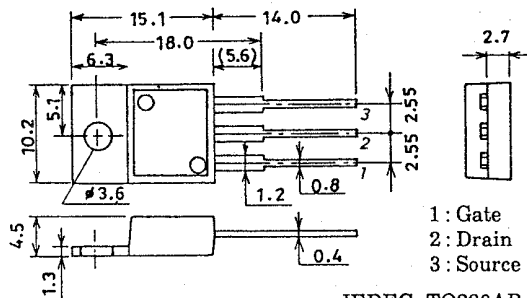
			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V _{(BR)DSS}	I _D = -1mA, V _{GS} = 0	-100			V
ゲート・ソース降伏電圧	V _{(BR)GSS}	I _G = ±100μA, V _{GS} = 0	±15			V
ドレイン・ソースしや断電流	I _{DSS}	V _{DS} = -100V, V _{GS} = 0			-100	μA
ゲート・ソースもれ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±12V, V _{DS} = 0			±10	μA
カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = -10V, I _D = -1mA	-1.0		-2.0	V
順伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} = -10V, I _D = -8A	7.5	13		S
飽和抵抗	R _{DS(on)}	I _D = -8A, V _{GS} = -10V		0.12	0.16	Ω
	R _{DS(on)}	I _D = -8A, V _{GS} = -4V		0.16	0.22	Ω
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = -20V, f = 1MHz		1900		pF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} = -20V, f = 1MHz		400		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} = -20V, f = 1MHz		80		pF
ターンオン遅延時間	t _{d(on)}	下図指定回路において		18		ns
立ち上がり時間	t _r	"		25		ns
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)}	"		300		ns
下降時間	t _f	"		120		ns
ダイオード順電圧	V _{SD}	I _S = -15A, V _{GS} = 0	-1.0		-1.5	V

スイッチングタイム測定回路



A05702

外形図 2052C
(unit: mm)



JEDEC: TO220AB
EIAJ : SC46

本製品は開発中です。
詳細については営業担当者にご連絡ください。